**Список публикаций Петросянца Константина Орестовича**

1. Petrosyants K.O., Sambursky L.M., Kharitonov I.A., Lvov B.G. Radiation-induced fault simulation of SOI/SOS CMOS LSI’s using universal Rad-SPICE MOSFET model//Journal of Electronic Testing. 2017. Т. 33. № 1. С. 37-51.
2. Petrosyants K.O., Samburskii L.M., Kharitonov I.A., Kozhukhov M.V. Measurements of the electrical characteristics of bipolar and MOS transistors under the effect of radiation//Measurement Techniques. 2017. С. 1-8.
3. Petrosyants K.O., Sambursky L.M., Kharitonov I.A., Lvov B.G. Fault simulation in radiation-hardened SOI CMOS VLSIs using universal compact MOSFET model//В сборнике: LATS 2016 - 17th IEEE Latin-American Test Symposium 17. 2016. С. 117-122.
4. Петросянц К.О. Моделирование элементов БИС с учетом радиационных эффектов. Часть 1. Приборно-технологические модели (TCAD-модели)// В сборнике: Микроэлектроника-2015. Интегральные схемы и микроэлектронные модули: проектирование, производство и применение сборник докладов Международной конференции. 2016. С. 415-431.
5. Petrosyants K.O., Popov D.A., Sambursky L.M., Kharitonov I.A. TCAD leakage current analysis of a 45 nm MOSFET structure with a high-k dielectric// Russian Microelectronics. 2016. Т. 45. № 7. С. 460-463.
6. Петросянц К.О., Самбурский Л.М., Харитонов И.А., Кожухов М.В. Измерения электрических характеристик биполярных и МОП-транзисторов под действием радиации//Измерительная техника. 2016. № 10. С. 55-60.
7. Петросянц К.О., Кожухов М.В. TCAD моделирование характеристик кремниевых и кремний-германиевых биполярных транзисторов с учетом радиационных эффектов// Проблемы разработки перспективных микро- и наноэлектронных систем (МЭС). 2016. № 4. С. 2-9.
8. Петросянц К.О., Кожухов М.В., Харитонов И.А., Самбурский Л.М. Особенности экстракции параметров схемотехнических SPICE-моделей биполярных и МДП-транзисторов с учётом влияния суммарной поглощённой дозы// В книге: Научная сессия НИЯУ МИФИ-2015 Аннотации докладов: в 3-х томах. Ответственный редактор О.Н. Голотюк. 2015. С. 120.
9. Петросянц К.О., Кожухов М.В. Моделирование с помощью системы TCAD влияния нейтронного и протонного излучений на характеристики биполярных транзисторов// В книге: Научная сессия НИЯУ МИФИ-2015 Аннотации докладов: в 3-х томах. Ответственный редактор О.Н. Голотюк. 2015. С. 119.
10. Петросянц К.О., Кожухов М.В. Влияние параметров слоя кремний-германиевой базы на эффект саморазогрева в структуре гетеропереходного биполярного транзистора// Известия высших учебных заведений. Электроника. 2015. Т. 20. № 6. С. 648-651.
11. Петросянц К.О., Харитонов И.А., Кожухов М.В., Самбурский Л.М. Схемотехнические SPICE-модели биполярных и МОП-транзисторов для автоматизации проектирования радиационно стойких БИС// Информационные технологии. 2015. Т. 21. № 12. С. 916-922.
12. Petrosyants K.O., Popov D.A. Modeling of nano-scale MOSFETs with different high-K gate stacks and polysilicon electrode//В сборнике: Актуальные направления фундаментальных и прикладных исследований Материалы V международной научно-практической конференции. 2015. С. 157-160.
13. Petrosyants K.O., Torgovnikov R.A. Electro-thermal modeling of trench-isolated SiGe HBTs using TCAD// В сборнике: Annual IEEE Semiconductor Thermal Measurement and Management Symposium 31. Сер. "31st Annual Semiconductor Thermal Measurement and Management Symposium, SEMI-THERM 2015 - Proceedings" 2015. С. 172-175.
14. Petrosyants K.O., Kozhukhov M.V. SiGe HBT TCAD simulation taking into account impact of proton radiation// В сборнике: Proceedings of the European Conference on Radiation and its Effects on Components and Systems, RADECS 15. Сер. "2015 15th European Conference on Radiation and Its Effects on Components and Systems, RADECS 2015" 2015. С. 7365666.
15. Petrosyants K.O., Popov D.A. TCAD simulation of total ionization dose response of 45nm high-k MOSFETs on bulk silicon and SOI substrate//В сборнике: Proceedings of the European Conference on Radiation and its Effects on Components and Systems, RADECS 15. Сер. "2015 15th European Conference on Radiation and Its Effects on Components and Systems, RADECS 2015" 2015. С. 7365671.

Ученый секретарь

диссертационного совета Д212.131.02

кандидат физико-математических наук Л.Ю. Фетисов